证券代码：688693　　证券简称：锴威特　　公告编号：2026-020

苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）

● 投资金额：使用额度不超过人民币1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度使用期限自苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月8日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限范围内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

● 特别风险提示：为控制风险，公司选择流动性好、安全性高的中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

现就该事项的具体情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

（三）额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（六）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持以规范运作、防范危险、谨慎投资为原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，旨在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，可以提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报，充分保障全体股东利益。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司选择流动性好、安全性高的中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定办理现金管理业务。

2、规范建账管理并实时跟踪。公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司财务部门及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计机构负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司履行的审议程序

公司于2026年4月8日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：688693　　证券简称：锴威特　　公告编号：2026-014

苏州锴威特半导体股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

1、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-90,782,595.70元，截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币-103,802,655.97元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司归属于母公司所有者的净利润为负数，综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司于2024年12月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行普通股取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股A股。基于上述情况，公司2025年度通过集中竞价交易方式累计回购股份605,400股，占公司总股本的0.82%，已支付的总金额为19,994,304.08元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

综上所述，公司2025年度现金分红和回购金额合计19,994,304.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为22.02%。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至本公告披露日，公司已上市满两个完整会计年度，本年度净利润为负值且母公司报表年度末未分配利润为负值，本次利润分配预案的实施公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月8日召开第三届董事会第七次会议审议通过了本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司实际经营情况，不会影响公司正常经营及长期发展。公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：688693　　证券简称：锴威特　　公告编号：2026-023

苏州锴威特半导体股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理司景喆先生的辞职报告。司景喆先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，司景喆先生将不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
司景喆	副总经理	2026年4月9日	2028年7月6日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，司景喆先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。司景喆先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好交接工作，其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

公司及公司董事会对司景喆先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：688693　　证券简称：锴威特　　公告编号：2026-017

苏州锴威特半导体股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月8日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元/年）
丁国华	非独立董事、董事长	131.17
罗　寅	非独立董事、总经理	116.84
陈　锴	非独立董事	0
彭占凯	非独立董事	0
严　弘	非独立董事、董事会秘书	105.10
陈桂庆	职工代表董事（新任）	8.47
秦　舒	独立董事	10.8
朱光忠	独立董事	10.8
张洪发	独立董事	10.8
谭在超	非独立董事（离任）、副总经理	116.78
司景喆	副总经理	106.78
刘姗姗	财务总监	60.21

注：税前报酬总额包括基本工资、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、非独立董事、高级管理人员薪酬方案

在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。月度绩效工资关联月度考核指标，按月发放；年度绩效工资平时不予发放，年终根据业绩完成情况核算，并在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。

2、独立董事薪酬方案

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年10.8万元，按月发放。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、鉴于年度审计报告于次年4月底前进行审议，故年度绩效薪酬在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

（五）公司履行的决策程序

1、董事会薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月8日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，逐项审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员在涉及自身薪酬情况相应子议案中回避了表决，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月8日召开第三届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事在涉及自身薪酬情况相应子议案中回避表决，同意将董事薪酬相关议案提交公司股东会审议。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026年4月10日

公司代码：688693　　公司简称：锴威特

苏州锴威特半导体股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内，公司实现营业总收入25,456.78万元，同比增长95.62%；归属于母公司所有者的净利润为-9,078.26万元，同比减亏640.67万元。受全球经济增速放缓及行业竞争加剧影响，公司产品售价与毛利率有所承压。与此同时，为构筑长期核心竞争力，公司坚持前瞻性战略布局，持续加大研发投入以覆盖全品类功率器件芯片，推动功率IC及第三代半导体产品的系列化、自主可控与成本优化，并同步强化市场推广、渠道建设及管理升级。尽管公司通过优化产品组合、迭代工艺平台及拓展市场实现了销售规模的增长，但短期营收尚无法覆盖中长期战略投入带来的成本费用的增加，致使净利润仍处于亏损状态。未来若市场需求波动、竞争加剧或产品迭代加速，而公司未能持续提升竞争力或充分释放规模效应，可能导致营收大幅波动并延长盈利周期，进而对现金流、财务状况及团队稳定产生不利影响。虽然公司已采取多项降本增效措施，但若未来无法有效应对上述挑战或控制成本，仍面临业绩持续亏损的风险。

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-90,782,595.70元，截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币-103,802,655.97元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司归属于母公司所有者的净利润为负数，综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，因此公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

√适用　□不适用

截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币103,802,655.97元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，改善经营业绩。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	锴威特	688693	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严弘	王勇
联系地址	张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢01室	张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢01室
电话	0512-58979950	0512-58979950
传真	/	/
电子信箱	zhengq@convertsemi.com	zhengq@convertsemi.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。公司坚持"自主创芯，助力核心芯片国产化"的发展定位，通过自主创新和技术沉淀，已同时具备功率器件和功率IC的设计、研发能力。在产品布局上，公司主要产品包含功率器件及功率IC两大类，同时也为部分客户提供芯片设计及工艺开发等技术服务。基于上述业务的协同效应，公司积极推进"功率器件+功率IC融合"战略，针对高可靠功率电源模块及电机驱动模块应用场景，提供覆盖各功率段的系统化芯片解决方案。

主要产品或服务情况如下：

1、功率器件方面

在功率器件方面，公司产品布局平面MOSFET、集成快恢复高压功率MOSFET（FRMOS）、中低压沟槽型MOSFET、超结MOSFET和SiC MOSFET产品。平面MOSFET产品已实现产品系列化，覆盖40~1500V电压段，已形成低压、中压、高压全系列功率MOSFET产品系列；在平面MOSFET工艺平台基础上设计研发了集成快恢复高压MOSFET（FRMOS）系列产品，产品采用重金属掺杂工艺，具有优异的反向恢复特性，可为客户降低系统功耗，解决系统电磁干扰问题；中低压沟槽型MOSFET在已有产品基础上，针对BMS、电机驱动等应用场景开发了抗短路能力强的30V、40V、60V、80V、100V沟槽屏蔽栅MOSFET；超结MOSFET采用多次外延的技术路线，已完成第2代和第3代超结技术平台的研发，形成600V~850V电压段产品系列化；SiC MOSFET产品是公司功率器件方向布局未来的重要产品线，公司与晶圆工厂密切合作，优化产品设计和工艺流程，提升产品竞争力，已从公司第2代SiC MOS提升到第3代SiC MOS技术平台，将1200V SiC MOS Ronsp降低至3.0mΩ*cm2以下，同时研发了集成SBD的SiC MOSFET，解决SiC MOSFET寄生二极管的缺陷问题，适用于OBC、电机驱动等应用场合，针对小电流SiC MOSFET ESD耐量弱的问题，研发集成ESD保护的SiC MOSFET，可以通过2KV的ESD耐量测试。

功率器件产品及应用方向如下：

产品种类	封装后成品示意图	产品特点	覆盖参数段	主要应用方向
平面 MOSFET		具有功率密度高、产品击穿耐压稳定性高、阈值电压一致性好、高温漏电小、开关损耗小、抗浪涌能力强等性能特点	电压范围：40V-1500V 电流范围：0.3A-190A	公司产品广泛用于LED 照明、电源适配器、智能家电、PC 电源、逆变器、智能电表等
集成快恢复高压功率 MOSFET（FRMOS）		采用重金属掺杂工艺制造，具有低反向恢复电荷、反向恢复时间短和低高温漏电流的特性	关键动态指标反向恢复电荷 Qrr＜0.2uC 反向恢复时间 Trr＜100ns 电压范围：300V-700V 电流范围：2A-94A	公司产品主要应用于直流无刷电机驱动、LLC 架构的大功率电源、高功率数字音频功放等
沟槽型 MOSFET		具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低、芯片体积小等特点	电压范围：30V-150V 电流范围：4A-300A	可广泛用于电动工具、BMS、智能家电主板等
超结 MOSFET		公司超结 MOSFET 采用多次外延工艺，具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低等特点	电压范围：600V-850V 电流范围：4A-80A	可广泛用于新能源汽车充电桩、服务器电源、通讯电源
SiC MOSFET		导通电阻小、开关损耗低、工作温度范围宽、阈值电压一致性好、可靠性高	电压范围：650V-3300V 电流范围：3A-200A	可广泛用于新能源汽车及配套、工业照明、大功率电源、高可靠领域等
SiC SBD		反向恢复时间短，反向恢复电荷小，工作温度范围宽	电压范围：650V-1200V 电流范围：2A-60A	可广泛用于新能源汽车及配套、大功率电源、逆变器、高可靠领域等

2、功率IC方面

公司功率IC产品主要围绕电源管理和电机驱动进行产品布局和研发，电源管理IC主要包括隔离和非隔离DC-DC、PFC控制器、理想二极管控制器、浪涌抑制控制器、高频栅极驱动器、高边电流采样放大器等产品。隔离和非隔离DC-DC产品涵盖反激、反激双路交错、正激有源钳位、推挽、半桥、全桥、移相全桥、降压、升压以及升降压等多拓扑配置，帮助客户灵活创建各种电源设计；同时集成了欠压、过压、过流、过热等多种保护功能，确保系统安全稳定工作，能够为客户提供隔离式开关电源系列化的解决方案。

电机驱动IC能够将电机控制器（MCU）输出的低压控制信号转换成驱动功率器件的高压驱动信号，来驱动功率器件进行开关动作，从而驱动电机工作，集成了高侧和低侧驱动器，可降低开关损耗，适应嘈杂的环境并提高系统效率。公司的驱动IC产品包含单相半桥、全桥、三相全桥产品系列，可满足多种场景的应用要求。

功率IC产品及应用方向如下：

产品种类	封装后成品示意图	产品特点	覆盖参数段	主要应用方向
PWM 控制 IC		产品主要为隔离式开关电源芯片，用于将输入电压的振幅转换成宽度一定的脉冲，使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定。产品涵盖反激、反激双路交错、正激有源钳位、推挽、半桥、全桥、移相全桥等多拓扑配置，帮助客户灵活创建各种电源设计，同时集成了欠压、过压、过流、过热等多种保护功能，确保系统安全稳定工作	工作电压范围，13V-120V 开关频率支持1MHz 以上	可广泛用于安防、工业及高可靠电源等
电机驱动 IC		产品主要为电机驱动 IC，包含单相半桥、全桥、三相全桥产品系列，用于将电机控制器/MCU 输出的低压控制信号转换成驱动功率器件的高压驱动信号，集成了高侧和低侧驱动器，可降低开关损耗，适应嘈杂的环境并提高系统效率，支持 TTL 和 CMOS 电平输入，低传输延迟、内部集成电滤泵，支持 100%占空比工作	工作电压范围，20V-600V 驱动电流最高可达 10A 开关频率可支持1MHz 以上	可广泛用于电机驱动、工业及高可靠电源等
DC-DC		产品主要为非隔离式开关电源芯片，是一种通过开关电源技术实现电压变换的电源产品，其核心特点是输入与输出之间没有电气隔离（即无变压器或光耦隔离）。这类拓扑结构简单、成本低、效率高，广泛应用于对体积、成本和效率敏感的场景。产品已涵盖同步降压控制器、同步升压控制器、同步降压转换器、异步降压转换器，既有功率器件集成的方案，适合小电流、小体积的场景，也有功率器件外置的方案，适合大电流的应用场景，方便用户选择。	工作电压范围，4-100V 开关频率支持1MHz 以上	可广泛应用于工业及高可靠电源、板卡电源等
理想二极管控制器		理想二极管控制器是一种专用电源管理 IC，用于控制低导通电阻的 MOSFET 来代替肖特基二极管，起到防反接的作用，可以降低 90%以上的导通损耗。	工作电压范围，3.3-100V	可广泛应用于工业及高可靠电源、BMS 系统等
浪涌抑制控制器		浪涌抑制控制器是一种专用电源管理 IC，通过控制高安全工作区的 MOSFET，抑制电源输入侧的浪涌电压尖峰和浪涌电流，保护后级系统，避免后级系统披浪涌电压、电流损坏的目的。	工作电压范围，10-100V	可广泛应用于车载系统、高可靠电源等

3、功率模块（功率器件+功率IC融合）

凭借公司拥有功率器件及功率IC核心研发能力的优势，打造智能功率模块和固态继电器等融合产品线，由高可靠领域向工控、新能源及智能家电市场拓展。

（1）智能功率模块（IPM）

公司同时拥有功率器件和功率IC的核心研发能力，具备将功率器件和功率IC进行融合，研发高性能智能功率模块的能力；公司上市后开始布局功率器件和功率IC融合的产品方向——智能功率模块。针对智能功率模块的技术要求，公司研发适配的集成OCP、OTP及LDO的半桥驱动IC和功率MOSFET，将其进行匹配封装成功率模块，充分发挥二者的性能，可为客户提供高性价比的智能功率模块，方便客户使用，缩短客户研发周期。

（2）固态继电器

随着第三代半导体SiC和GaN器件的成熟，使固态继电器由小电流向大电流产品渗透成为可能。公司已研发成功适配SiC MOSFET的固态继电器专用光电转换驱动IC，已成功应用于储能、新能源汽车等应用中。同时公司布局新一代的固态继电器驱动IC产品，具备更强驱动能力，用于驱动大电流SiC MOSFET，提高固态继电器的电流能力，满足大电流应用场合。

4、技术服务

公司在开发产品的同时，利用长期积累的设计经验和工艺开发能力，为客户提供芯片设计及工艺开发等技术服务，公司技术服务主要覆盖高可靠领域客户，包括产品开发和工艺开发流片两类。

产品开发：在该类技术服务过程中，由客户定义产品的功能和参数指标，委托公司对该产品进行设计开发，后续公司根据客户的具体需求，可以为客户提供制版、流片和测试验证等技术服务工作。

工艺开发流片：客户基于晶圆厂已有工艺平台，需要开发新的器件或者其他工艺升级要求。在工艺开发流片的服务过程中，由公司负责新器件工艺开发或为客户提供其指定需求的工艺服务。后续由客户基于公司提供的工艺服务自行设计产品，并委托公司进行制版、流片的服务。而产品的测试验证等工作由客户自行负责。

2.2 主要经营模式

公司为采用Fabless经营模式的芯片设计企业，将晶圆制造和封测环节委外，晶圆代工厂根据公司提供的产品设计版图、工艺制程要求完成晶圆的加工制造，经公司验收后，公司再根据市场需求对其进行委外封装和测试。通过将制造、封装、测试环节委外，公司可将研发力量集中于功率半导体芯片设计环节，专注于自身所擅长的领域，提升核心竞争力；同时Fabless经营模式较IDM经营模式更为灵活，公司可快速根据市场变化进行产品结构调整。

1、研发模式

公司制定了系统的研发管理制度和版图设计流程规范，包括《产品设计开发控制程序》《版图设计管理规定》《产品验证管理规定》《工程封装管理规定》等，对研发过程中各个环节进行了规范，保证设计研发产出符合公司要求规定，从而提升研发产出效率和成功率。研发流程主要包括论证阶段、设计阶段、工程试制阶段和定型阶段。

2、采购模式

公司采购内容主要包括晶圆和封装测试服务。公司自主设计研发相关产品，再委托晶圆代工厂商生产并向其采购。晶圆采购根据公司是否提供原材料外延片分为直接委外和带料委外两种采购形式；对于直接委外，晶圆代工厂自行采购外延片并根据公司设计版图（公司设计版图的具体载体为GDS文件或掩膜版）及工艺要求制造出公司所需晶圆，向公司销售加工后晶圆；对于带料委外，由公司提供外延片，晶圆代工厂仅负责晶圆制造，根据公司提供的设计版图及工艺要求制造出公司所需晶圆，并向公司收取加工费。两种模式所采购晶圆均为公司自主设计研发。对于加工后晶圆，晶圆代工厂具备中测条件的，公司会直接采购中测后晶圆，如晶圆代工厂不具备中测条件，公司采购加工后晶圆后，再另行委外中测，中测完成后入库。

公司制定了《采购控制程序》，对晶圆、外延片、封装、包辅料等采购流程制定了严格规定并遵照执行。公司还制定了《供应商开发和管理程序》《wafer委外加工管理规定》《CP委外加工管理规定》《封装委外加工管理规定》等规定，对各类外协采购进行严格管理和控制，保证外协采购内容满足公司要求。

3、销售模式

公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，主要直销客户多为业内知名的芯片设计、方案公司及高可靠领域客户；经销客户为公司的经销商。公司的经销模式为买断式，属于行业内的常规模式。公司制定了《成品客户管理规定》《报价管理规定》《售后服务管理制度》《客户投诉处理控制程序》等规定，其中对经销商的导入、价格制定、客诉流程等方面均作出了详细规定，公司与经销商均签署《产品授权经销协议》，对双方的权利和义务作出明确规定。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段

公司主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。根据《中华人民共和国国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"。

功率半导体自诞生以来，历经七十余年的研究与应用，已从基材迭代、结构设计优化、先进封装形式创新、大尺寸晶圆应用等多个维度实现技术突破，其演进的主要方向围绕更高功率密度、更小体积、更低功耗及损耗展开，其结构设计朝着理想目标不断改进，以适应日益多元化的应用场景需求。据Yole Développement数据显示，功率半导体器件每隔二十年将进行一次产品迭代，相比其他半导体，迭代周期相对平缓，每一代芯片都拥有较长的生命周期。

MOSFET作为功率器件中市场份额占比最高的产品类型，具有开关速度快、输入阻抗高、导通内阻小、易于驱动、热稳定性好等优点，既可在低电流和低电压条件下工作，也可应用于大电流开关电路和高频高速电路，应用场景十分广泛。自上世纪70年代MOSFET诞生以来，发展至今已有数十年历史，技术和工艺不断成熟，从平面MOSFET发展到Trench MOSFET，再到SGT MOSFET和SJ MOSFET，再到当前备受关注的第三代功率MOSFET（SiC、GaN）。整体来看，功率MOSFET的技术迭代方向主要围绕制程升级、结构设计优化、工艺改进以及材料革新展开，以实现器件的高频率、高功率和低损耗的高性能要求。

功率半导体的应用范围极为广泛，几乎覆盖了电子制造业的各个领域。据Omdia数据，2024年全球功率器件（含SiC）规模为530.6亿美元。预计2024~2029年，全球功率器件有望维持8.43%的年复合增长率，2029年市场规模预计增长至795.3亿美元。近年来，随着电子制造业向发展中国家和地区转移，中国半导体行业实现快速发展，芯片设计、晶圆制造能力与国际先进水平差距持续缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，产业集聚效应日益凸显。作为全球最大的功率半导体市场，中国正从市场应用中心向产业技术创新高地转型，在全球功率半导体格局中的影响力持续提升。目前，中国占据全球功率半导体市场最大份额，为本土企业提供了广阔的进口替代空间，且这一替代趋势已取得实质性进展，国内龙头企业士兰微和比亚迪在2024年成功跻身全球功率半导体市场前十。

当前，全球正经历以人工智能技术为代表的新一轮技术变革，AI算力爆发、AIDC数据中心扩建等趋势深刻重塑功率半导体行业的发展格局，推动行业呈现出鲜明的变化趋势。AI服务器、大模型训练等场景对算力的极致追求，直接带动功率半导体需求激增，服务器单机功率大幅提升，机柜功耗大幅攀升，对电源管理产品的数量和性能提出更高要求，成为行业增长的核心新引擎，加速了功率半导体的技术迭代与产品升级，推动行业竞争焦点向高端领域转移。为适配高功率、低损耗应用场景的需求，功率半导体在材料、封装、结构设计等方面持续突破，SiC、GaN等高端工艺逐步成为主流，封装技术向小型化、集成化升级。

近年来，中国陆续出台多项产业政策，对功率半导体行业发展进行规范与引导。作为国民经济的关键支柱产业，功率半导体持续获得政策倾斜。国家通过制定专项产业政策，提供研发资金支持、给予税收优惠等一系列措施，大力推动本土半导体产业链建设，重点聚焦于供应链安全提升与技术自主可控实现。这些举措既呼应了行业发展的迫切需求，也为国内功率器件企业创造了宝贵的发展窗口与市场机遇。总体而言，各项政策的落地实施，有效推动了功率半导体行业市场规模的稳步增长，并促进行业朝向健康、稳定、有序的方向发展。

（2）行业的基本特点

功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心，可实现电源开关和电能转换的功能，实现变频、变相、变压、逆变、变流、开关的目的，几乎覆盖了所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等产业，同时在新能源汽车、充电桩、数据中心、风光发电、储能、智能装备制造、机器人、5G通讯等新兴领域也有广泛应用。从20世纪50年代发展至今，功率半导体已形成以二极管、晶闸管、MOSFET、IGBT等为代表的多世代产品体系，不同产品在功率、频率、开关速度等参数上具有各自优势，市场呈现多世代并存、协调发展的特点。

全球半导体材底材料已经发展到第三代，包括以硅（Si）、锗（Ge）等为代表的第一代元素半导体材料，目前仍是功率半导体市场主流材底材料；以砷化镓（GaAs）等为代表的第二代化合物半导体材料，主要应用于特定高频场景；以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等为代表的第三代宽禁带半导体材料，凭借更高的能效、功率密度等优势，近年来应用规模持续增长，成为行业技术升级和需求增长的核心突破口，尤其在人工智能、新能源等新兴场景中应用需求日益凸显。其中，碳化硅作为由碳和硅稳定结合而成的晶体材料，具备高温稳定性、高硬度、耐腐蚀性等优异特性，其热导率比硅高2~3倍，不仅能大幅提升电源转换效率，也是解决散热难题的潜力材料。据Wolfspeed预测，2026年SiC相关器件市场有望达到89亿美元，衬底市场有望达到17亿美元，合计市场超百亿。

（3）所属行业主要技术门槛

1）功率器件的技术门槛

功率器件种类较多，主要包括二极管、三极管（BJT）、晶闸管、MOSFET和IGBT等。其中，二极管、晶闸管、三极管（BJT）的优点是成本低，生产工艺相对简单，在中低端领域大量应用；MOSFET、IGBT等器件结构相对复杂，工艺门槛和生产成本相对较高，系具有较高技术先进性的产品。根据Yole Développement预测，到2028年功率器件将以Si基MOSFET、IGBT、SiC基MOSFET为主导，其中MOSFET在所有功率器件类别中占比最高，占比达30%，需求保持稳定增长。

功率器件的研发与生产是一项高度复